# English Translation-in-part of Japanese Unexamined Patent Publication No. 196372/1995

## [Abstract]

[Purpose] To produce a boron nitride ceramic excellent in heat resistance, corrosion resistance, lubricity, insulating properties, etc., at low cost by pyrolyzing a specified polyborazine-based compound.

[Constitution] This ceramic is produced by pyrolyzing a polyborazine-based compound composed mainly of a repeating unit represented by the formula and having 300 to 100000 number-average molecular weight. This ceramic is a boron nitride ceramic composed essentially of boron, nitrogen and silicon and only pyrolytic BN is discovered by XRD measurement. After heat treatment at 200 °C in an atmosphere of an inert gas, this ceramic has <=500Angstrom average crystallite size of (002) plane and (100) plane based on calculation by Scherre equation. In the formula, A show H, R<8> or SIR<2>R<3>R<4> (R<2>, R<3>, R<4> and R<8> are each H, a 1 to 20C alkyl or an aryl) and may be same or mutually different in the intra-repeating unit or the inter-repeating units. All A are not H.

(Page 5, lines 31 to 45 of the right column)

[Problems to be Solved by the Invention]

Known methods of using boron nitride precursor polymer have characteristics as follows:

(a) Boron nitride precursor polymer containing a carbon component such as alkyl or phenyl is soluble in solvent and is easy to form since it is relatively stable, however, much carbon component remains in ceramic

after heat decomposition. Since free carbon in ceramic causes phase separation or reaction at high temperature, there are problems that high resistance properties of ceramics and high insulation and thermal shock resistance which is inherent properties of boron oxide are significantly reduced.

(b) Boron nitride precursor polymer which does not contain or contains small amount of a carbon component such as alkyl or phenyl contains less amount of carbon after thermal decomposition, however, it is not easy to solve in solvent and is poor in formability since it is low in stability. Accordingly, it is impossible to simultaneously obtain good formability of boron nitride precursor polymer and ceramic with low carbon after thermal decomposition according to the conventional methods.

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-196372

(43)公開日 平成7年(1995)8月1日

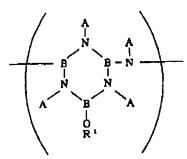
| (51) lnt.Cl.*<br>C 0 4 B 35 | 機別配号<br>/583        | 庁 <b>内整理番号</b> | F I      |                      |                            |            | 技術法                 | 绿   | 箇所         |
|-----------------------------|---------------------|----------------|----------|----------------------|----------------------------|------------|---------------------|-----|------------|
| C07F 5                      | /05<br>/08 NUR      | 7457-4H        |          |                      |                            |            | •                   |     |            |
| 0144                        | , 11011             |                | C04B     | 35/ 58               | 103                        | A<br>Z     |                     |     |            |
|                             |                     |                | 審查請求     | 朱龍朱                  | 請求項の数 5                    | FD         | (全                  | 8   | 頁)         |
| (21)出觀番号                    | <b>特閣平</b> 5-352318 |                | (71)出顧人  | 3900229              |                            |            |                     |     |            |
| (22)出顧日                     | 平成5年(1993)、12月29日   |                | (72)発明者  | 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番1号    |                            |            |                     |     |            |
|                             | •                   |                | (72)発明者  | 青木 6<br>埼玉県7         |                            | ●ヶ岡        | 1 丁目                | 3 種 | <b>‡</b> 1 |
|                             |                     |                | (72)発明者  | 中原 花<br>埼玉県ス<br>号 東州 | 5彦<br>人間郡大井町西省<br>5株式会社総合9 | か 岡<br>F究所 | 1 丁目 :              | 3 # | <b>‡</b> 1 |
|                             |                     |                | (74)復代理人 | と野舟                  | 学 学 工一                     |            | 5名)<br><b>B終頁</b> ( | こ新  | <b>E</b> < |

## (54) 【発明の名称】 全化研集質セラミックスとその製法

## (57)【要約】

【目的】 低コスト、容易成形性、高強度 (特に高温下)のBN系セラミックス (特に成形体)の製造。 【構成】 B, N, Siを必須元素とし、XRD測定でも一BNのみが観測され、Scherre式で (002)面、(100)面の結晶子径の平均値が500点以下のBN質セラミックス。下記式

[1k1]



(式中、AはH, R<sup>8</sup> 又は-SiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> (R<sup>2</sup> , R<sup>3</sup> ,R<sup>4</sup> ,R<sup>8</sup> はH、アルキル基又はアリール基を表 わす)であるが、全てのAがHではない。)のユニット を有するポリポラジン系化合物を熱分解する。 【特許請求の範囲】

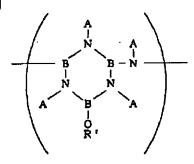
【請求項1】 硼素、窒素及び珪素を必須元素とし、XRD(X RayDiffractometer) 測定で熱分解型BN(turbostratic BN)のみが観測され、かつ不活性ガス中2000でで熱処理後にScherre式により算出した(002) 面および(100) 面の結晶子径の平均値が500人以下であることを特徴とする窒化硼素質セラミックス。

【簡求項2】 構成元素の比率が原子比でN/Bが0.05~3.0、Si/Bが0.05~3.0、O/Bが10以下、C/Bが1.0以下である簡求項1記載の窒化硼素質セラミックス。

【請求項3】 成形体である請求項1又は2記載の窒化 磁素セラミックス。

【請求項4】 主として下記一般式

【化1】



(式中、Aは繰り返し単位内及び繰り返し単位間で同じでも異なってもよく、水素原子、R®またはーSiR² R® R であるが、R², R³, R4, R6 はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1~20個を有するアルキル基またはアリール基を表わし、すべてのAが水素原子ではない。)で表わされる繰り返し単位を有し、数平均分子量が300~100,000の範囲にあるポリポラジン系化合物を熱分解することを特徴とする窒化硼素質セラミックスの製造方法。

【請求項5】 的記ポリポラジン化合物を成形し、熱分解して窒化硼素質セラミックス成形体を得る請求項4記載の窒化硼素質セラミックスの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は窒化硼素質セラミックスとその製造方法に係り、この窒化硼素系セラミックスは耐熱性、耐食性、潤滑性および絶縁性等に優れた材料であり、化学、金属、電気、航空、宇宙、模械、精密、自動車等の各産業での広範な利用が期待できる。

[0002]

【従来の技術】これまでに知られている熱分解窒化硼素 (t-BN)、六方晶系窒化硼素(h-BN)の常圧合 成方法の主なものは(1)金属硼素、酸化硼素、硼酸塩 などをNHs、金属シアン化物等と反応させる方法、 (2) BCla, Bz He 等のガスをNHs と反応させる方法、また本出願と同様に前駆体ポリマーを経由する方法としては(3) ポラジン環化合物を原料として合成したポリマーを熱分解する方法などである。(3) の合成方法の主なものは以下のとおりである。

【0003】 ① アルキル基、フェニル基およびメチルアミノ基を持つボラジン化合物を熱縮合して登化硼素系セラミックス前駆体ポリマー (ポリアミノボラジン)を合成し、これを加熱分解する。 [R.H. Toeniskoetter, F.R. Hall, Inorg. Chem., 2, 29(1963) 及び特公昭51-53000号(1976)]

② BートリアミノーNートリス(トリメチルシリル) ポラジンを熱縮合して窒化硼繁系セラミックス前駆体ポ リマーを合成し、これをN2 中あるいはNH3中で熱分 豚する。 [K.J.L.Paciorek、W.Krone-Schmidt, D.H.Har ris、R.H.Kratzer, K.Wynne, J.Am.Chem.Soc.Symp.Se r., 360, 392(1988)及びU.S.Patent 4707556(1987)]

② Bートリアミノポラジンを熱縮合して窒化硼素系セラミックス前駆体ポリマーを合成し、これを圧縮成形し 20 で窒素気流中で熱分解する。〔林信行、木村良晴他、第8回無機高分子討論会、12(1989)〕

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上記の①は反応に高温 / 高圧が必要であること、成形性が悪いなどの問題点を 持つ。②の方法もガスを原料とするため任意の形状の成 形体製造は困難であり、またこれらのガスは危険性が高 いため取り扱いが難しい等の点で問題がある。③のセラ ミックス前駆体ポリマーを経由する方法は本出願と同様 に成形性が高い点で優れているが、以下に示す問題点が 30 ある。\_\_

【0005】・これまで知られている空化硼素前駆体ボリマーを経由する方法は次の特徴を持つ。(a)アルキル基、フェニル基等の炭素成分を含むものは溶媒に可溶であり、比較的安定であるため成形が容易だが、熱分解後のセラミックス中に炭素成分が多く残存する。セラミックス中に遊離炭素は高温で相分離や反応を引き起こすためセラミックスの強度特性の低下や窒化硼素、酸化硼素に本来固有の高絶縁性、耐熱衝撃性が著しく低下する難点がある。(b)アルキル基、フェニル基等の炭素成分を含まないかあるいは少ないものは熱分解後のセラミックス中の炭素量は少ないが、溶媒に溶解しにくく、かつ安定性が低いため成形性が悪い。したがって、既存の方法では前駆体ポリマーの成形性と熱分解後のセラミックスの低炭素化の両立が不可能である。

【0006】・これまで知られている常圧合成法による 窓化硼素セラミックスは1200℃付近の温度で六方晶型(hexagonal)の結晶を生成する。結晶が成 長する過程において生ずる異なる結晶面の境界(粒界) は、一般的にセラミックスの強度を低下させる要因とな 50 る。・高価なポラジン環化合物を原料とするため製造コ

-2-

ストが高い。

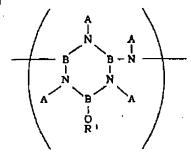
[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記の如き従来技術の問題点を解決するために、硼素、窒素及び珪素を必須元素とし、XRD(X Ray Diffractometer)測定で熱分解型BN(turbostratic BN)のみが観測され、かつ不活性ガス中2000℃で熱処理後にScherre式により算出した(002)面および(100)面の結晶子径の平均値が500人以下であることを特徴とする窒化硼素質セラミックスと製造する方法として、主として下配一般式

3

[0008]

[12]



【0009】(式中、Aは繰り返し単位内及び繰り返し単位間で同じでも異なってもよく、水素原子、R®または一SiR<sup>2</sup>R<sup>8</sup>R<sup>4</sup>であるが、R<sup>2</sup>, R<sup>8</sup>, R<sup>4</sup>, R ® はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1~20個を有するアルキル基またはアリール基を表わし、すべてのAが水素原子ではない。)で表わざれる繰り返し単位を有 30し、数平均分子量が300~100,000の範囲にあるポリボラジン系化合物を熱分解することを特徴とする方法を提供する。

【0010】本発明の瞳化硼素質セラミックスは、硼素及び窒素と共に珪素を必須元素とすることを第1の特徴とする。これは出発ポリマーが有機シリル基を含むことに帰因するが、出発ポリマーが有機シリル基を含むことによって、出発ポリマーは溶剤可溶性であり、成形の容易性、セラミックス収率の向上、セラミックス中の炭素の低減に有利である。

【0011】具体的には、本発明の窒化硼素質セラミックスは下配原子比の元素を含む。

N/B 0.05~3.0、好ましくは0.3~2. 0、より好ましくは0.5~1.5

Si/B 0.05~3.0、好ましくは0.05~ 1.0、より好ましくは0.05~0.5

O/B 10以下、好ましくは3以下、より好ましく は1以下

C/B 1以下、好ましくは0.5以下、より好まし くは0.1以下 第2に、本発明の窒化硼素質セラミックスは熱分解型窒化硼素(t-BN)からなることを特散とする。これは高温まで(1800℃以上まで)結晶の成長が抑制されることを意味し、これによって強度、特に高温強度が高い利点がある。従来の窒化硼素では1200℃以上になると六方晶型BN、熱分解型BNが現われる。

【0012】第3に、上記と関連して、本発明の窒化硼素質セラミックスはt-BNの結晶子径の平均値が小さいことを特徴とし、Scherre式により算出した(002)面(d=3.33A)および(100)面(d=2.17A)の結晶子径の平均値が500A以下、より好ましくは100A以下である。一般に、X線ディフラクトメーター(XRD)で回折線を測定したが新によりがある。(A)結晶子の大きさ、(B) X線の試料によるものと、(A)結晶子の大きさ、(B) 不均一歪、(C) 積層不整などの試料によるものがある。以下に示すScherrer式は結晶に(B),(C)の様な不完全性がなくプロファイルの拡がりが結晶子の大きさだけに因り、かつその大きさが均一であると仮定した場合の結晶子径を求める理論式である。

[0013] Dhki =  $K \lambda / (\beta \cos \theta)$ 

Dhki : hkl面の結晶子の大きさ(A)

λ:測定X線の波長(A)

β:結晶子の大きさによる圓折線の拡がり (ラジアン)

θ:回折線のプラック角

K:定数(半値幅法の場合0.9)

本発明の氢化硼素質セラミックスの結晶子径の算出は熱分解型BN(turbostratic)の002面(d=3.33A)および100面(d=2.17A)のX線プロファイルの半値幅の平均値から上配のScherrer式により算出した値を用いる。

【0014】この小さい結晶子径は、少なくとも窒素硼素質セラミックスを1800℃48hr以上、より好ましくは2000℃48hr以上で熱処理しても保持される。さらに、本発明の窒化硼素質セラミックスは出発ポリマーが安価であるため、製造コストが低い利点がある。このような本発明の窒化硼素質セラミックスは下記一般式(I)

40 [0015]

[123]

50

A A A B A B

【0016】(式中、Aは繰り返し単位内及び繰り返し単位間で同じでも異なってもよく、水素原子、R®または一SiR²R³R⁴であるが、R²R³,R⁴,R %はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1~20個を有するアルキル基またはアリール基を表わし、すべてのAが水素原子ではない。)で表わされる繰り返し単位を有し、数平均分子量が300~100,000の範囲にあるポリボラジン系化合物(I)を熱分解して製造できる。

\*して一般式B(OR')3(式中、R'は同一でも異なってもよく、水素原子、炭素数1~20個を有するアルキル基またはアリール基を表わし、少なくとも1個のR は上記のアルキル基またはアリール基である。)で表わされる硼素アルコキシドを、NH3又はR®NH 3と、一般式

R<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> SiNHSiR<sup>5</sup> R<sup>6</sup> R<sup>7</sup> (式中、R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R<sup>5</sup>, R<sup>6</sup>, R<sup>7</sup>. R<sup>8</sup> はそれぞれ独立に水素原子、炭素数1~20個を有するアルキル基またはプリール基を表わし、少なくとも1個のR<sup>1</sup> は上記アルキル基またはアリール基を表わす。)で表わされるジシラザン化合物の存在下で反応させ、さらに必要に応じて無重合を進めることによって製造することができる。

【0018】上記製法のうち、硼素アルコキシドとNH3をアルキルジシラザンの存在下で反応させる方法は、本出願人が先に特願平5-272351号に開示した。この合成反応は、典型的には、下記反応式で表わすことができるであろう。

[0019]

【0017】このポリポラジン系化合物 (I) は、主と\*20 【化4】 3B(OR') + 2NH + 2R'R'R'SINHSIR'R'N'

(Ath-SiR'R'R' 又はH)

【0020】製法の詳細は特願平5-272351号を 参照されたいが、一般的に述べると、溶媒中に各反応体 を存在させ、30~300℃程度の温度で反応させるだ けでよい。この製法は出発原料が安価であるため製造コ ストが低いこと、また反応制御が容易であること、生成 するポリポラジン系化合物が溶剤可溶型で安定な化合物 であることなどを特徴としている。

【0021】上記の報法によって生成するポリポラジン 系化合物は、主として一般式

[0022]

【化5】

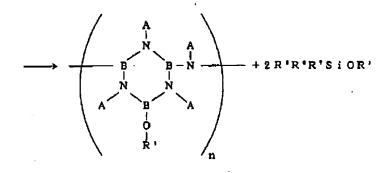
【0023】 (式中、Aは繰り返し単位内及び繰り返し単位間で同じでも異なってもよく、水素原子、R<sup>0</sup> または-SiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> であるが、R<sup>2</sup>, R<sup>3</sup>, R<sup>4</sup>, R はそれぞれ独立して水素原子、炭素数1~20個を有するアルキル基またはアリール基を表わし、すべてのA が水素原子ではない。)で表わされる繰り返し単位を有

しており、このポリマーは、一般式には、ボラジン環が -NH-を介して結合した線状構造物であるが、硼素原 子に結合している-OR!が窒素原子に結合しているA 又はHあるいは原料のジシラザン化合物(R<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> SiNSiR<sup>5</sup> R<sup>5</sup> R<sup>7</sup>)と反応してより複雑な構造や 架橋構造を取ることも可能である。 \*(I)は、上記合成方法においてNH3をR®NH2 (R®は水素原子、炭素数1~20個を有するアルキル差またはアリール蓋を表わす。)で代えることによっても製造できる。この合成反応は、典型的には、下記反応式で表わすことができるであろう。

[0025]

【0024】また、本発明のポリポラジン系化合物 \* 【化6】

3 B (OR') + 2 R'NH, + 2 R'R'R'S I NHS I R'R'N'



(Aは-SIR"R"R', R"又はH)

【0026】そして、この合成方法は、NH3をR<sup>8</sup> NH2で代える以外、特顧平5-272351号に開示した方法と基本的に同様であることができる。なお、R<sup>1</sup> ~R<sup>8</sup> は炭素数の少ない世接差が好ましい。セラミックス収率の向上およびセラミックス中の炭素数の低減に有利であるためである。これらのポリマーはHと一〇R<sup>1</sup> 基とアルキルシリル基(-SiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup>)を持つ。ポリマー申のH, -OR<sup>1</sup> 基および-SiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> 基の存在量は反応原料の混合割合を変化させることにより調節できる。ポリマーは一〇R<sup>1</sup> 基とアルキルシリル基(-SiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup>)を持つためベンゼン、トルエン、キシレン、テトラヒドロフラン(THF)等に可溶である。

【0027】また、これらのボリマーは十分な安定性を持つ。乾燥雰囲気下であれば室温で長時間保存してもポリマーの物性は変化しない。これはポリマー内に安定な富能基-OR<sup>1</sup> 基とアルキルシリル基(-SiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup>)を持つためであると考えられる。上記のボリマー(ポリボラジン系化合物)は通常固化および焼成工程をへて窒化硼素質セラミックスに転換される。

【0028】上記ポリマーの固化は単独でも硬化剤やセラミックス粉末を混合させてもよい。固化工程の条件すなわち温度、圧力、雰囲気ガスおよび保持時間等は硬化剤やセラミックス粉末の有無あるいは使用量によって適宜選定される。特に限定するわけではないが、一般的には下記の如くである。例えば、ポリマー単独の場合には、これを炭化水素類、ハロゲン化炭化水素類、エーテル類等の有機溶媒に溶解させ、これを必要に応じて任意の形状の成形型に充填する。次に常圧下で使用した有機

答媒の沸点以上の温度で加熱するか、あるいは減圧下で 加熱し有機溶媒を除去することによって固化し得る。

【0029】また、液体状のポリマーを使用する場合には、これを必要に応じて任意の形状の成形型に充填した後、真空下、あるいは後配する種々のガス雰囲気下常圧から10気圧で室温から400℃の任意の温度に昇温し、その温度に保持することによって固化される。固化時間は0.5時間から72時間の範囲である。さらに、固体状のポリマーを任意形状の成形型に充填し、常温から400℃前記雰囲気ガス下で常圧から10気圧の範囲で保持する方法でもよい。

【0030】雰囲気ガスとしては、窒素、アルゴン等の 不活性ガス、アンモニア、水素、メチルアミン、ヒドラ ジン等の還元性ガス、空気、酸素、オゾン等の酸化性ガ スあるいはこれらの混合ガスが使用できる。また、硬化 剤としてはアルキルアミン、アルキレンジアミン等の右 機アミン類、シュウ酸無水物、マロン酸無水物等のカル ポン酸無水物、アルキルイソシアネート、ジメチルシリ ルジイソシアネート等のイソシアネート類、プタンジチ オール、ペンゼンジチオール等のチオール類、マロン酸 イミド、コハク酸イミド等のカルボキシイミド類、元素 周期律表第11a族および第111族~第V族の郡から選択 される金属を含む金属アルコキシド類、鉄、コパルト、 ニッケル、縄、銀、金、水銀、亜鉛、ルテニウム、パラ ジウム、インジウム、チタン、ハフニウム、ジルコニウ ム、アルミニウム、ホウ素、リン等のハロゲン化物等が 使用される。

ル銀等の有機溶媒に溶解させ、これを必要に応じて任意 【0031】また、クラック発生防止及び強度の増大をの形状の成形型に充填する。次に常圧下で使用した有機 50 目的として、必要に応じて添加されるセラミックス粉末

としては各種金属の窒化物、炭化物、酸化物などが挙げられる。成形型としては従来公知のものが任意に使用できるが、成形体の取り出し性や成形体の裏面を保護するために成形型内に離型剤、たとえばシリコーンをベースとした化合物などを塗布したり、あるいはグリースを薄く塗布するか、有機溶剤に分散したグリースをスプレーまたは刷毛塗等の塗布手段により塗布しておくことが好ましい。

【0032】上記園化工程の後、続いて好ましくは前記 した不活性ガス、遠元性ガス、酸化性ガスあるいはこれ 10 らの混合ガスの存在下で加熱焼成される。この焼成の条 件も限定するわけではないが、一般に、20℃/min 以 下好ましくは5℃/min 以下で400℃から1800~ 2300℃に加熱昇温させ、この温度でさらに通常48 時間以内保持することにより行なう。場合によってはホ ットプレス等の加圧焼成により良好な結果が得られる。 【0033】この焼成工程においてポリマー中のORI 基とアルキルシリル差 (-SiR<sup>2</sup>R<sup>3</sup>R<sup>4</sup>)が反応し TB-N結合を生成する。この時OR1 基とアルキルシ リル差 (-SiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> ) が結合して得られるR<sup>1</sup> OSiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> が生成する。これによってセラミッ クス化が進行するとともにポリマー中の炭素成分が飛散 し、炭素含有量の少ないセラミックスが得られる。な お、生成したR<sup>1</sup> OSiR<sup>2</sup> R<sup>3</sup> R<sup>4</sup> は安定な化合物で あるため、ポリマーあるいは焼成後のセラミックスと再 反応することはない。

【0034】また、本発明の窒化硼素質セラミックスは 1800℃以上、好ましくは2000℃以上の高温まで 結晶の成長が抑制される。これは同セラミックス中が前 配の前駆体ポリマーを経由して合成されたことによるものと考えられる。焼成温度が400℃未満であるとセラミックス化が不十分となり、また十分な硬度を付与できない。また、温度が2300℃を越えると好ましくない 結晶の成長が顕著になり、強度低下が大きくなる。

【0035】本発明のセラミックス(特に成形体)は前 記の様な方法によって製造されるが、焼成後のセラミッ クス(成形体)に前記のポリマーを含浸させ、固化、焼き \*成を繰り返し行なえば、良好なセラミックスを得ることもある。また、本発明の前駆体ポリマーはコーティング 後焼成して窒化硼素質セラミックスコーティングを提供することも可能である。あるいは、得られたセラミック スは粉砕して窒化硼素質セラミックス粉末とすることができる。

10

[0036]

【实施例】

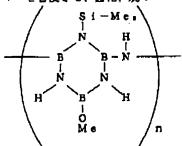
#### 実施例1

内容積2 LのSUS-316製反応器内部を乾燥窒素で置換した後、乾燥窒素で1kg/cm²Gまで加圧する。この反応器内に乾燥ビリジン(C5 H5 N)601.4gを導入する。これに攪拌しながらトリメチルボレート(B(OMe)3)62.5g(0.601mol)、つぎにヘキサメチルジシラザン[((CH3)\$Si)2NH]290.3g(1.803mol)を加えた。次にNH330.8g(1.812mol)を反応器内に導入した後、反応器を密閉した。これを160℃で反応させると淡赤色の溶液が得られた。反応終了後、溶媒を減圧除去すると36.5gの淡赤色の粘性液体が得られた。この粘性液体はペンゼン、トルエン、キシレン、THFに容易に溶解した。

【0037】生成したポリマーの数平均分子量は、凝固点降下法(溶媒:乾燥ベンゼン)により測定したところ750であった。N-H(3350cm<sup>-1</sup>)、CHs およびOCHs (2960及び2850cm<sup>-1</sup>)、B-OおよびB-N(1300~1540cm<sup>-1</sup>)、Si-Me(1250cm<sup>-1</sup>)、B-N[ボラジン環)(860cm<sup>-1</sup>)の吸収が観測された。生成物の元素祖成分析結果(重量%)はB:17.6;N:24.8;Si:14.0;O:7.9;C:28.1;H:7.6であった。このポリマーのベンゼン裕液(50wt%)を窒素雰囲気下、室温で6カ月間放置したが、分子量、元素組成に変化は見られなかった。なお、このポリマーの構造は下配であると認定された。

[0038]

【化7】



Me:メチル基

【0039】得られたポリマーをトルエンに溶解し、漫度を調整した後、テフロン製成形型に流し込み、窒素気流下200℃で溶媒を除くことにより透明な成形体を得 50

た (20mm ¢ × 10mm)。次にNHs ガス雰囲気下で1 ℃/min の昇温速度で1000℃まで昇温させ、続いて 窒素ガス雰囲気中で10℃/min の昇温速度で1700

でまで昇温させ、1700℃で1時間焼成することにより白色の円盤状セラミックスを得た。このセラミックスの元素担成分析結果(重量%)はB:35、4;N:54.2;Si:6.8;O:3.5;C:0.1であった。

【0040】つづいてこの試料をN2 ガス中2000℃での焼成後にScherrer式により算出した002 面および100面の結晶子径の平均値は85Aであった。

#### 実施例2

【0041】生成したポリマーの数平均分子量は、疑固点降下法(溶媒:乾燥ペンゼン)により測定したところ750であった。N-H(3350cm<sup>-1</sup>)、CHs およびOCHs (2960及び2850cm<sup>-1</sup>)、B-OおよびB-N(1300~1540cm<sup>-1</sup>)、Si-Me(1250cm<sup>-1</sup>)、B-N[ポラジン環](860cm<sup>-1</sup>)の吸収が観測された。生成物の元素祖成分析結果(重量%)はB:17.6;N:24.8;Si:14.0;O:7.9;C:28.1;H:7.6であった。このポリマーのペンゼン溶液(50wt%)を窒素雰囲気下、窒温で6カ月間放置したが、分子量、元素組成に変化は見られなかった。

【0043】つづいてこの試料を№ ガス中2000℃での焼成後にScherrer式により算出した002 面および100面の結晶子径の平均値は150Aであった。

#### 実施例3

内容積2LのSUS-316製反応器内部を乾燥窒素で

置換した後、乾燥窒素で1kg/cm²Gまで加圧する。この 反応器内に乾燥ピリジン (Cs Hs N) 801. 4gを 導入する。これに攪拌しながらトリメチルポレート (B (OMe) \*\*) 62.5g (0.601mol)、つぎにヘキサメチルジシラザン [ ((CH\*\*) 3Si) 2NH] 290.3g (1.803mol)を加えた。次にNH\*\*30、8g (1.812mol)を反応器内に導入した後、反 応器を密閉した。これを160℃で反応させると淡赤色

12.

の溶液が得られた。反応終了後、溶媒を減圧除去すると 36.5gの淡赤色の粘性液体が得られた。この粘性液 体はペンゼン、トルエン、キシレン、THFに容易に溶 解した。

【0044】生成したポリマーの数平均分子量は、疑固点降下法(溶媒:乾燥ベンゼン)により測定したところ750であった。N-H(3350cm<sup>-1</sup>)、CH<sub>3</sub>およびOCH<sub>3</sub>(2960及び2850cm<sup>-1</sup>)、B-OおよびB-N(1300~1540cm<sup>-1</sup>)、Si-Me(1250cm<sup>-1</sup>)、B-N[ボラジン環](860cm<sup>-1</sup>)の吸収が観測された。生成物の元素相成分析結果(重量%)はB:17.6;N:24.8;Si:14.0:0:7.9;C:28.1;H:7.6であった。このボリマーのベンゼン溶液(50wt%)を窒素雰囲気下、室温で6カ月間放置したが、分子量、元素組成に変化は見られなかった。

【0045】得られたポリマーをトルエンに溶解し、濃度を調整した後、テフロン製成形型に流し込み、窒素気流下200℃で溶媒を除くことにより透明な成形体を得た(20mm × 10mm)。次に空気雰囲気下で1℃/mlnの昇温速度で1200℃まで昇温させ、1200℃で1時間焼成することにより白色の円盤状セラミックスを得た。このセラミックスの元素祖成分析結果(重量%)はB:30.2;N:39,7;Si:7.5;O:22.5;C:0.1であった。

【0046】つづいてこの試料をN2 ガス中2000℃での焼成後にScherrer式により算出した002 面および100面の結晶子径の平均値は210Aであった。

#### [0047]

【発明の効果】本発明は下記の如き有利な効果を奏する。・本発明の窒化硼素質セラミックスは上記の前駆体ポリマーを経由して合成されるため、比較的温和な温度、圧力下で自由な形状のセラミックスを得ることができる。

【0048】・本発明に示すポリマーは一OR! 巻とアルキルシリル巻(一SiR² R² R² R4)を含むため、有機溶媒への溶解性が高い。これにより成形が容易である。・本発明に示すポリマーに含まれる一OR! 巻とアルキルシリル巻(一SiR² R3 R4)はポリマーをある程度安定化する効果を持つ。このため、成形などの取り扱いが容易である。

50

【0049】・本発明に示すポリマーは一〇R1 基とアルキルシリル基(-SiR2 R3 R4)の両方を持つ。これらの基は焼成工程において反応して安定な化合物 R1 OSiR2 R3 R4 を生成して飛散するため、焼成後のセラミックス中の炭素含有量を低減できる。・本発明の登化硼素質セラミックスは上記の前駆体ポリマーを経

14 由して合成されるため、2000℃の高温まで結晶粒の 成長を抑制できる。

【0050】・本発明の窒化硼素質セラミックスの前駆体ポリマーは硼素アルコキシド、NHs、アルキルシラザン類を原料として合成されるため、ポラジン環化合物を原料とする場合と比較して製造コストが低い。

フロントページの続き

## (72)発明者 舟山 徹

埼玉県入間郡大井町西鶴ヶ岡1丁目3番1 号 東燃株式会社総合研究所内

### (72) 発明者 磯田 武志

埼玉県入間郡大井町西鶴ヶ岡1丁目3番1 号 東燃株式会社総合研究所内